



(19)

(11) Publication number: **10242483 A**

Generated Document.

**PATENT ABSTRACTS OF JAPAN**(21) Application number: **09040977**(51) Intl. Cl.: **H01L 29/84 G01C 19/56 G01P 9/04 G01P 15/125**(22) Application date: **25.02.97**

(30) Priority:

(43) Date of application publication: **11.09.98**

(84) Designated contracting states:

(71) Applicant: **MITSUBISHI MATERIALS CORP**(72) Inventor: **SHIBATANI HIROSHI  
MURAISHI KENSUKE**

(74) Representative:

**(54) MANUFACTURE OF  
SEMICONDUCTOR  
INERTIA SENSOR**

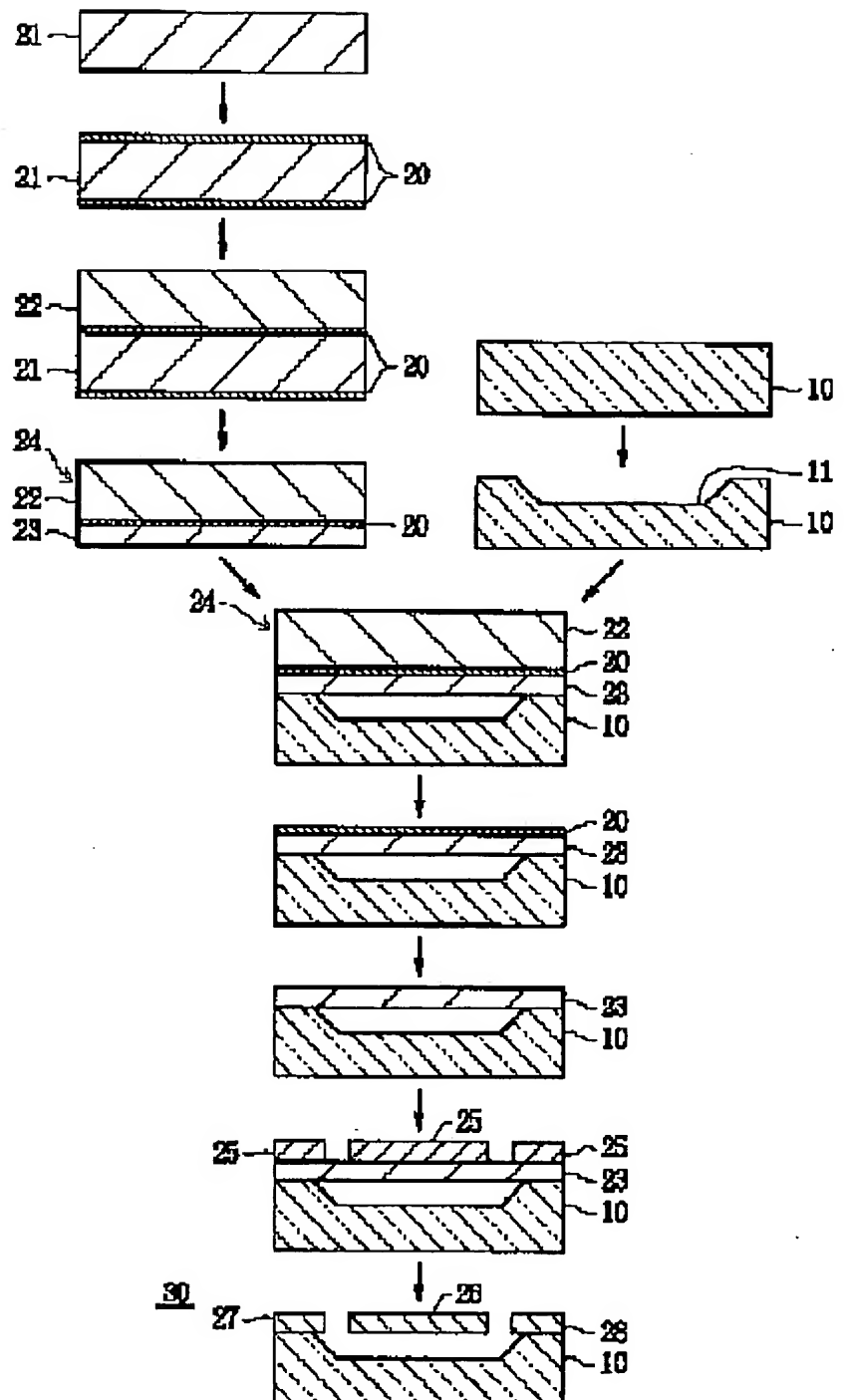
(57) Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To obtain a semiconductor inertia sensor which eliminates the need for a wafer pasting operation and a laser beam machining operation, which is suitable for high volume production and which is low-cost and to obtain a semiconductor inertia sensor whose parasitic capacitance is low and which is high in sensitivity and high in accuracy.

**SOLUTION:** A second silicon wafer 22 is pasted on one face of a first silicon wafer 21 in which films 30 such as oxide films, nitride films or the like are formed on both faces, the other face of the first silicon wafer is polished, a single-crystal silicon layer 23 is formed, a structure 24 which contains the single-crystal silicon layer is bonded to a glass substrate 10

in such a way that the single-crystal silicon layer is faced with a recess 11 on the glass substrate 10, and the second silicon wafer and the films 20 are removed. When the exposed single-crystal silicon layer is etched and removed selectively, a semiconductor inertia sensor 30 which is provided with fixed electrodes 27, 28 and with a moving electrode 26 sandwiched between them and which is levitated at the upper part of the glass substrate is obtained.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-242483

(43) 公開日 平成10年(1998) 9月11日

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>  
 H 0 1 L 29/84  
 G 0 1 C 19/56  
 G 0 1 P 9/04  
 15/125

識別記号

F I

H 0 1 L 29/84  
 G 0 1 C 19/56  
 G 0 1 P 9/04  
 15/125

Z

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願平9-40977

(22) 出願日 平成9年(1997) 2月25日

(71) 出願人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72) 発明者 柴谷 博志

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

(72) 発明者 村石 賢介

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

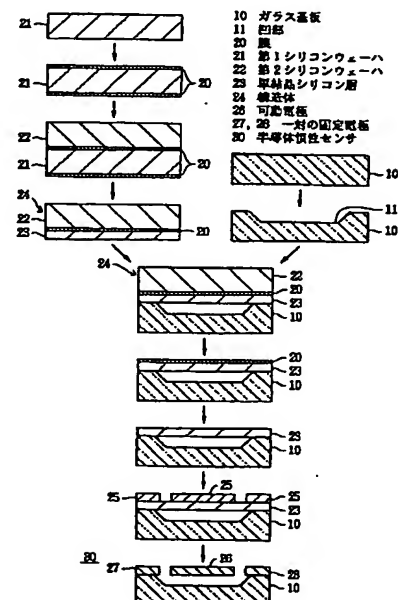
(74) 代理人 弁理士 須田 正義

(54) 【発明の名称】 半導体慣性センサの製造方法

## (57) 【要約】

【課題】 ウェーハの貼り合わせやレーザ加工が不要で大量生産に適する、低コストの半導体慣性センサを得る。また寄生容量が低く、高感度で高精度な半導体慣性センサを得る。

【解決手段】 酸化膜、窒化膜等の膜20が両面に形成された第1シリコンウェーハ21の片面に第2シリコンウェーハ22を貼り合わせ、第1シリコンウェーハの他面を研磨して単結晶シリコン層23を形成し、単結晶シリコン層を含む構造体24を単結晶シリコン層がガラス基板10の凹部11に対向するようにガラス基板に接合した後、第2シリコンウェーハ及び膜20を除去する。露出した単結晶シリコン層を選択的にエッチング除去することにより、固定電極27、28とこれらに挟まれかつガラス基板の上方に浮動する可動電極26とを有する半導体慣性センサ30を得る。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 シリコンウェーハ(21)の片面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を介して単結晶シリコン層(23)が形成された構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)を対向させてガラス基板(10)に接合する工程と、

前記シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、  
前記膜(20)を除去して前記単結晶シリコン層(23)を露出させた後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極(27,28)と前記一対の固定電極(27,28)に挟まれかつ前記ガラス基板(10)の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)とを有する半導体慣性センサ(30)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【請求項 2】 ガラス基板(10)の表面に検出電極(12)を形成する工程と、

シリコンウェーハ(21)の片面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を介して単結晶シリコン層(23)が形成された構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)を対向させてガラス基板(10)に接合する工程と、

前記シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、

前記膜(20)を除去して前記単結晶シリコン層(23)を露出させた後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に前記検出電極(12)に対向して浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)を有する半導体慣性センサ(40)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【請求項 3】 ガラス基板(10)の表面に検出電極(12)を形成する工程と、

シリコンウェーハ(21)の片面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を介して単結晶シリコン層(23)が形成された構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)を対向させてガラス基板(10)に接合する工程と、

前記シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、

前記膜(20)を除去して前記単結晶シリコン層(23)を露出させた後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極(27,28)と前記固定電極(27,28)に挟まれかつ前記検出電極(12)に対向して前記検出電極(12)の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)とを有する半導体慣性センサ(50)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【請求項 4】 ガラス基板(10)に凹部(11)を形成する工程と、

第 1 シリコンウェーハ(21)の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を形成する工程と、

第 2 シリコンウェーハ(22)を前記第 1 シリコンウェーハ(21)の片面に前記膜(20)を介して貼り合わせる工程と、  
前記第 1 シリコンウェーハ(21)の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層(23)を形成する工程と、  
前記単結晶シリコン層(23)、前記膜(20)及び前記第 2 シリコンウェーハ(22)からなる構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)が前記凹部(11)に対向するように前記ガラス基板(10)に接合する工程と、

10 前記第 2 シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、

前記膜(20)を除去して前記単結晶シリコン層(23)を露出させた後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極(27,28)と前記一対の固定電極(27,28)に挟まれかつ前記ガラス基板(10)の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)とを有する半導体慣性センサ(30)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【請求項 5】 ガラス基板(10)に凹部(11)を形成する工程と、

20 前記ガラス基板(10)の凹部(11)の底面に検出電極(12)を形成する工程と、

第 1 シリコンウェーハ(21)の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を形成する工程と、

第 2 シリコンウェーハ(22)を前記第 1 シリコンウェーハ(21)の片面に前記膜(20)を介して貼り合わせる工程と、  
前記第 1 シリコンウェーハ(21)の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層(23)を形成する工程と、

30 前記単結晶シリコン層(23)、前記膜(20)及び前記第 2 シリコンウェーハ(22)からなる構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)が前記凹部(11)に対向するように前記ガラス基板(10)に接合する工程と、

前記第 2 シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、

前記膜(20)を除去して前記単結晶シリコン層(23)を露出させた後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に前記検出電極(12)に対向して浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)を有する半導体慣性センサ(40)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【請求項 6】 ガラス基板(10)に凹部(11)を形成する工程と、

40 前記ガラス基板(10)の凹部(11)の底面に検出電極(12)を形成する工程と、

第 1 シリコンウェーハ(21)の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を形成する工程と、

50 第 2 シリコンウェーハ(22)を前記第 1 シリコンウェーハ(21)の片面に前記膜(20)を介して貼り合わせる工程と、  
前記第 1 シリコンウェーハ(21)の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層(23)を形成する工程と、

前記単結晶シリコン層(23)、前記膜(20)及び前記第2シリコンウェーハ(22)からなる構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)が前記凹部(11)に対向するように前記ガラス基板(10)に接合する工程と、

前記第2シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、

前記膜(20)を除去して前記単結晶シリコン層(23)を露出させた後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極(27,28)と前記固定電極(27,28)に挟まれかつ前記検出電極(12)に対向して前記検出電極(12)の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)とを有する半導体慣性センサ(50)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【請求項7】 ガラス基板(10)に凹部(11)を形成する工程と、

第1シリコンウェーハ(21)の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を形成する工程と、

第2シリコンウェーハ(22)を前記第1シリコンウェーハ(21)の片面に前記膜(20)を介して貼り合わせる工程と、前記第1シリコンウェーハ(21)の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層(23)を形成する工程と、

前記単結晶シリコン層(23)、前記膜(20)及び前記第2シリコンウェーハ(22)からなる構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)が前記凹部(11)に対向するように前記ガラス基板(10)に接合する工程と、

前記第2シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、

前記膜(20)を選択的に除去した後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極(27,28)と前記一対の固定電極(27,28)に挟まれかつ前記ガラス基板(10)の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)とを有する半導体慣性センサ(30)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【請求項8】 ガラス基板(10)に凹部(11)を形成する工程と、

前記ガラス基板(10)の凹部(11)の底面に検出電極(12)を形成する工程と、

第1シリコンウェーハ(21)の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を形成する工程と、

第2シリコンウェーハ(22)を前記第1シリコンウェーハ(21)の片面に前記膜(20)を介して貼り合わせる工程と、前記第1シリコンウェーハ(21)の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層(23)を形成する工程と、

前記単結晶シリコン層(23)、前記膜(20)及び前記第2シリコンウェーハ(22)からなる構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)が前記凹部(11)に対向するように前記ガラス基板(10)に接合する工程と、

前記第2シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、

前記膜(20)を選択的に除去した後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に前記検出電極(12)に対向して浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)を有する半導体慣性センサ(40)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【請求項9】 ガラス基板(10)に凹部(11)を形成する工程と、

前記ガラス基板(10)の凹部(11)の底面に検出電極(12)を形成する工程と、

第1シリコンウェーハ(21)の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜(20)を形成する工程と、

第2シリコンウェーハ(22)を前記第1シリコンウェーハ(21)の片面に前記膜(20)を介して貼り合わせる工程と、前記第1シリコンウェーハ(21)の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層(23)を形成する工程と、

前記単結晶シリコン層(23)、前記膜(20)及び前記第2シリコンウェーハ(22)からなる構造体(24)を前記単結晶シリコン層(23)が前記凹部(11)に対向するように前記ガラス基板(10)に接合する工程と、

前記第2シリコンウェーハ(22)を前記膜(20)をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、

前記膜(20)を選択的に除去した後、前記単結晶シリコン層(23)を選択的にエッチング除去することにより、前記ガラス基板(10)上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極(27,28)と前記固定電極(27,28)に挟まれかつ前記検出電極(12)に対向して前記検出電極(12)の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極(26)とを有する半導体慣性センサ(50)を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法。

【発明の詳細な説明】  
【0001】  
【発明の属する技術分野】本発明は、静電容量型の加速度センサ、角速度センサ等に適する半導体慣性センサ及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来、この種の半導体慣性センサとして、①ガラス基板と単結晶シリコンの構造からなる共振角速度センサが提案されている(M. Hashimoto et al., "Silicon Resonant Angular Rate Sensor", Technica l Digest of the 12th Sensor Symposium, pp.163-166 (1994))。このセンサは両側をトーションバーで浮動するようにした音叉構造の可動電極を有する。この可動電極は電磁駆動によって励振されている。角速度が作用すると可動電極にコリオリ力が生じて、可動電極がトーションバーの回りに振り振動を起こして共振する。センサはこの可動電極の共振による可動電極と検出電極との間の静電容量の変化により作用した角速度を検出する。こ

て、①ガラス基板と単結晶シリコンの構造からなる共振角速度センサが提案されている(M. Hashimoto et al., "Silicon Resonant Angular Rate Sensor", Technica l Digest of the 12th Sensor Symposium, pp.163-166 (1994))。このセンサは両側をトーションバーで浮動するようにした音叉構造の可動電極を有する。この可動電極は電磁駆動によって励振されている。角速度が作用すると可動電極にコリオリ力が生じて、可動電極がトーションバーの回りに振り振動を起こして共振する。センサはこの可動電極の共振による可動電極と検出電極との間の静電容量の変化により作用した角速度を検出する。こ

のセンサを作製する場合には、厚さ200 $\mu$ m程度の結晶方位が(110)の単結晶シリコン基板を基板表面に対して垂直にエッチングして可動電極部分などの構造を作製する。この比較的厚いシリコン基板を垂直にエッチングするためにはSF<sub>6</sub>ガスによる異方性ドライエッチングを行うか、或いはトーションバーの可動電極部分への付け根の隅部にYAGレーザで孔あけを行った後に、KOHなどでウェットエッチングを行っている。エッチング加工を行ったシリコン基板は陽極接合によりガラス基板と一体化される。

【0003】また別の半導体慣性センサとして、②シリコン基板上にエッチングで犠牲層をパターン化した後、除去することにより可動電極としてのポリシリコン振動子を形成したマイクロジャイロ (K. Tanaka et al., "A micromachined vibrating gyroscope", Sensors and Actuators A 50, pp.111-115 (1995)) が開示されている。このマイクロジャイロは、いわゆる表面マイクロマシニング技術を用いた構造となっている。具体的には、シリコン基板に不純物拡散によって検出電極を形成し、その上に犠牲層となるリン酸ガラス膜を成膜してパターンニングした後、ポリシリコンを成膜し、更に垂直エッチング等の加工を行って構造体を形成する。最後に犠牲層をエッチングにより除去することにより、可動電極部分を切り離して検出電極に対してギャップを作り出し可動電極を浮動状態にする。

【0004】更に別の半導体慣性センサとして、③ガラス基板と単結晶シリコンの構造からなるジャイロスコープが提案されている (J. Bernstein et al., "A Micromachined Comb-Drive Tuning Fork Rate Gyroscope", IEE E' MEMS '93 Proceeding, pp.143-148 (1993))。このジャイロスコープは、検出電極を形成したガラス基板と、エッチングを行った後に高濃度ボロン拡散を行って可動電極、固定電極等を形成した単結晶シリコン基板とをボロン拡散を行った部分を接合面として接合し、更にボロンを拡散していないシリコン基板部分をエッチングにより除去することにより、作られる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 上記①～③の従来のセンサの製造技術には、次の欠点があった。①の共振角速度センサの製造方法では、ガラス基板に対して浮動する構造になるべきシリコン能動部が陽極接合時に静電引力によりガラス基板に貼り付いて可動電極にならないことがあった。この貼り付き (sticking) を防ぐために可動電極と検出電極とを短絡して静電力が働かない状態で陽極接合した後に、レーザを用いて短絡していた電極間を切り離していた。また島状の固定電極を形成するためにガラス基板に接合した後、レーザアシストエッチングを行う必要があった。これらのレーザ加工は極めて複雑であって、センサを量産しようとする場合には不適切であった。

【0006】②のマイクロジャイロは、シリコンウェーハを基板とするため、センサの寄生容量が大きく、感度や精度を高くすることが困難であった。更に③のジャイロスコープの製造方法では、ボロンを拡散した部分をエッチストップ部分として構造体全体を形成するため、エッチストップ効果が不完全の場合にはオーバエッチングにより可動電極や固定電極の厚さが薄くなり、寸法精度に劣る問題点があった。

【0007】更に①及び③においては、可動電極部と検出電極部とのアライメントは陽極接合時に行われるが、基板どうしを密着させる段階や、加熱を行ったときに生じる温度分布や熱膨張率の違いなどによりずれが生じるため、このアライメントは一般に精度が低い。可動電極と検出電極の位置関係のずれは、センサの出力に悪影響を及ぼしやすいという問題点があった。

【0008】本発明の目的は、レーザ加工が不要で大量生産に適する、低コストの半導体慣性センサの製造方法を提供することにある。本発明の別の目的は、寄生容量が低く、高感度で高精度の半導体慣性センサの製造方法を提供することにある。本発明の更に別の目的は、寸法精度に優れた半導体慣性センサの製造方法を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】 請求項1に係る発明は、図1に示すように、シリコンウェーハ21の片面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を介して単結晶シリコン層23が形成された構造体24を前記単結晶シリコン層23を対向させてガラス基板10に接合する工程と、シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を除去して単結晶シリコン層23を露出させた後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつガラス基板10の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とを有する半導体慣性センサ30を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。

【0010】請求項2に係る発明は、図4に示すように、ガラス基板10の表面に検出電極12を形成する工程と、ガラス基板10の凹部11の底面に検出電極12を形成する工程と、シリコンウェーハ21の片面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を介して単結晶シリコン層23が形成された構造体24を前記単結晶シリコン層23を対向させてガラス基板10に接合する工程と、シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を除去して単結晶シリコン層23を露出させた後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に検出電極12に対向して浮動する単結

晶シリコンからなる可動電極26を有する半導体慣性センサ40を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。

【0011】請求項3に係る発明は、図5に示すように、ガラス基板10の表面に検出電極12を形成する工程と、ガラス基板10の凹部11の底面に検出電極12を形成する工程と、シリコンウェーハ21の片面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を介して単結晶シリコン層23が形成された構造体24を前記単結晶シリコン層23を対向させてガラス基板10に接合する工程と、シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を除去して単結晶シリコン層23を露出させた後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と固定電極27、28に挟まれかつ検出電極12に対向して検出電極12の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とを有する半導体慣性センサ50を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。

【0012】請求項4に係る発明は、図1に示すように、ガラス基板10に凹部11を形成する工程と、第1シリコンウェーハ21の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を形成する工程と、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21の片面に膜20を介して貼り合わせる工程と、第1シリコンウェーハ21の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層23を形成する工程と、単結晶シリコン層23、膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に接合する工程と、第2シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を除去して単結晶シリコン層23を露出させた後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつガラス基板10の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とを有する半導体慣性センサ30を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。

【0013】請求項5に係る発明は、図4に示すように、ガラス基板10に凹部11を形成する工程と、ガラス基板10の凹部11の底面に検出電極12を形成する工程と、第1シリコンウェーハ21の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を形成する工程と、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21の片面に膜20を介して貼り合わせる工程と、第1シリコンウェーハ21の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層23を形成する工程と、単結晶シリコン層23、膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる

構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に接合する工程と、第2シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を除去して単結晶シリコン層23を露出させた後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に検出電極12に対向して浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26を有する半導体慣性センサ40を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。

【0014】請求項6に係る発明は、図5に示すように、ガラス基板10に凹部11を形成する工程と、ガラス基板10の凹部11の底面に検出電極12を形成する工程と、第1シリコンウェーハ21の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を形成する工程と、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21の片面に膜20を介して貼り合わせる工程と、第1シリコンウェーハ21の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層23を形成する工程と、単結晶シリコン層23、膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に接合する工程と、第2シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を除去して単結晶シリコン層23を露出させた後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつガラス基板10の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とを有する半導体慣性センサ50を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。

【0015】請求項7に係る発明は、図7に示すように、ガラス基板10に凹部11を形成する工程と、第1シリコンウェーハ21の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を形成する工程と、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21の片面に膜20を介して貼り合わせる工程と、第1シリコンウェーハ21の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層23を形成する工程と、単結晶シリコン層23、膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に接合する工程と、第2シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を選択的に除去した後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつガラス基板10の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とを有する半導体慣性センサ30を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。



【0016】請求項8に係る発明は、図8に示すように、ガラス基板10に凹部11を形成する工程と、ガラス基板10の凹部11の底面に検出電極12を形成する工程と、第1シリコンウェーハ21の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を形成する工程と、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21の片面に膜20を介して貼り合わせる工程と、第1シリコンウェーハ21の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層23を形成する工程と、単結晶シリコン層23、膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に接合する工程と、第2シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を選択的に除去した後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に検出電極12に対向して浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26を有する半導体慣性センサ40を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。

【0017】請求項9に係る発明は、図9に示すように、ガラス基板10に凹部11を形成する工程と、ガラス基板10の凹部11の底面に検出電極12を形成する工程と、第1シリコンウェーハ21の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を形成する工程と、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21の片面に膜20を介して貼り合わせる工程と、第1シリコンウェーハ21の別の片面を所定の厚さに研磨して単結晶シリコン層23を形成する工程と、単結晶シリコン層23、膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に接合する工程と、第2シリコンウェーハ22を膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程と、膜20を選択的に除去した後、単結晶シリコン層23を選択的にエッチング除去することにより、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつ検出電極12に対向して検出電極12の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とを有する半導体慣性センサ50を得る工程とを含む半導体慣性センサの製造方法である。

【0018】この請求項1ないし9に係る製造方法では、レーザ加工が不要で大量生産に適するため、低コストで半導体慣性センサを製造できる。また基板にガラス基板を用いるので、センサは寄生容量が低い。また可動電極部と検出電極部とのアライメントを両者の接合時に行う従来技術に比べて、本願の請求項2、3、5、6、8及び9に係る製造方法では、可動電極部を形成する前に両者の接合を行うため、接合時に検出電極部とのアライメントを行う必要がなく、可動電極形成時に精度良くアライメントを行うことができるので、可動電極と検出

電極との位置関係のずれは最小限に抑えられる。このため高感度で高精度な半導体慣性センサが作られる。

【0019】なお、本明細書で、「シリコンを浸食せずにエッチング可能な膜」とは、当該膜をエッチング除去する際にシリコンが浸食されないエッチャントを選ぶことができる膜であることを意味する。また、この膜をエッチストップ層として利用する際には、前記エッチャントとは異なるエッチャントによって、シリコンのみをエッチングすることが可能である。このような性質の膜としては酸化膜や窒化膜等が挙げられる。本発明において、第2シリコンウェーハ22の結晶方位は、エッチング速度を考慮した場合、(110)方位のものが好ましく使用される。

#### 【0020】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基いて詳しく説明する。図1及び図2に示すように、本発明の第1実施形態の半導体慣性センサ30は加速度センサであって、ガラス基板10上に固着された固定電極27及び28の間に可動電極26を有する。可動電極26、固定電極27及び28は、それぞれ単結晶シリコンからなり、電極26と電極27及び電極26と電極28の互いに対向する部分が櫛状に形成される。可動電極26はガラス基板10の上方に位置し、ビーム31、31によりその両端が支持され、ガラス基板10に対して浮動になっている。ビーム31の基端部31aは基板10上に固着される。図示しないが、ビーム基端部31a、固定電極27及び28には個別に電気配線がなされる。この半導体慣性センサ30では、可動電極26に対して、図の矢印で示すようにビーム基端部31aと31aを結ぶ線に直交する水平方向の加速度が作用すると、可動電極26はビーム31、31を支軸として振動する。可動電極26と固定電極27及び28の間隔が広がり、狭まったりすると、可動電極26と固定電極27及び28の間の静電容量が変化する。この静電容量の変化から作用した加速度が求められる。

【0021】次に、本発明の第1実施形態の半導体慣性センサ30の製造方法について述べる。図1に示すように、先ずガラス基板10にフッ酸などのエッチャントでエッチングして凹部11を形成する。一方、第1シリコンウェーハ21の両面にシリコンを浸食せずにエッチング可能な膜20を形成する。この膜20としては、第1シリコンウェーハ21を熱酸化することにより形成される酸化膜の他、化学気相成長(CVD)法で $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$ 又は $\text{SiH}_4$ と $\text{NH}_3$ ガスを用いて形成される窒化シリコン膜などが挙げられる。両面に酸化膜20を形成した後、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21に酸化膜20を介して貼り合わせる。第2シリコンウェーハ22が貼り合わされていない側の第1シリコンウェーハ21の表面をその上に形成されている酸化膜20と共に砥石及び研磨布を用いて所定の厚さに研削研



磨して単結晶シリコン層23を形成する。その結果、単結晶シリコン層23、酸化膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる構造体24が形成される。この構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に陽極接合する。その後、KOHなどのエッチャントにより第2シリコンウェーハ22を酸化膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する。次いで酸化膜20をフッ酸などのエッチャントにより除去して単結晶シリコン層23を露出させる。その後、露出した単結晶シリコン層23の表面にスパッタリングによりアルミニウム(A1)膜25を形成し、パターニングした後、SF<sub>6</sub>ガスによる低温での異方性ドライエッチングを行い、最後にA1膜25を除去する。これにより単結晶シリコン層23が選択的にエッチング除去され、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつガラス基板10の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とが形成された半導体慣性センサ30が得られる。

【0022】図3及び図4は第2実施形態の半導体慣性センサ40を示す。この半導体慣性センサ40は加速度センサであって、検出電極12が表面に形成されたガラス基板10上に固着された枠体29の間に可動電極26を有する。可動電極26、枠体29は、それぞれ単結晶シリコンからなり、電極26は窓枠状の枠体29に間隔をあけて収容される。可動電極26は検出電極12の上方に位置し、ビーム31、31によりその両端が支持され、ガラス基板10に対して浮動になっている。ビーム31の基端部31aは枠体29の凹み29aに位置しかつ基板10上に固着される。図示しないが、ビーム基端部31a及び検出電極12には個別に電気配線がなされる。この半導体慣性センサ40では、可動電極26に対して、図の矢印で示すようにビーム基端部31aと31aを結ぶ線に直交する鉛直方向の加速度が作用すると、可動電極26はビーム31、31を支軸として振動する。可動電極26と検出電極12の間の間隔が広がったり、狭まったりすると、可動電極26と検出電極12の間の静電容量が変化する。この静電容量の変化から作用した加速度が求められる。

【0023】次に、本発明の第2実施形態の半導体慣性センサ40の製造方法について述べる。図4に示すように、先ずガラス基板10にフッ酸などのエッチャントでエッチングして凹部11を形成し、この凹部11の底面にスパッタリング、真空蒸着などによりAu、Pt、Cuなどから選ばれた金属の薄膜からなる検出電極12を形成する。一方、第1実施形態の製造方法と同様に行い、第1シリコンウェーハ21を熱酸化してその両面に酸化膜20を形成する。その後、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21に酸化膜20を介して貼り合わせる。第2シリコンウェーハ22が貼り合わさ

れていない側の第1シリコンウェーハ21の表面をその上に形成されている酸化膜20と共に所定の厚さに研削研磨して単結晶シリコン層23を形成する。その結果、単結晶シリコン層23、酸化膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる構造体24が形成される。この構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に陽極接合する。その後、第2シリコンウェーハ22を酸化膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する。次いで酸化膜20を除去して単結晶シリコン層23を露出させる。その後、露出した単結晶シリコン層23の表面にスパッタリングによりA1膜25を形成し、パターニングした後、SF<sub>6</sub>ガスによる低温での異方性ドライエッチングを行い、最後にA1膜25を除去する。これにより単結晶シリコン層23が選択的にエッチング除去され、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる枠体29、29と枠体29、29に挟まれかつ検出電極12の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とが形成された半導体慣性センサ40が得られる。

【0024】図5及び図6は第3実施形態の半導体慣性センサ50を示す。この半導体慣性センサ50は角速度センサであって、ガラス基板10上に固着された固定電極27及び28の間に音叉構造の一対の可動電極26、26を有する。可動電極26、固定電極27及び28は、それぞれ単結晶シリコンからなり、電極26と電極27及び電極26と電極28の互に対向する部分が櫛状に形成される。可動電極26、26はガラス基板10に形成された凹部11の上方に位置し、コ字状のビーム31、31によりその両端が支持され、ガラス基板10に対して浮動になっている。ビーム31の基端部31aは基板10上に固着される。この凹部11の底面には凹部の深さより小さい厚さの検出電極12が形成される。図示しないが、ビーム基端部31a、固定電極27及び28、検出電極12には個別に電気配線がなされ、固定電極27及び28に交流電圧を印加し、静電力により可動電極を励振するようになっている。この半導体慣性センサ50では、可動電極26、26に対してビーム基端部31aと31aを結ぶ線を中心として角速度が作用すると、可動電極26、26にコリオリ力が生じてこの中心線の回りに振り振動を起こして共振する。この共振時の可動電極26と検出電極12との間の静電容量の変化により作用した角速度が検出される。

【0025】次に、本発明の第3実施形態の半導体慣性センサ50の製造方法について述べる。図5に示すように、先ずガラス基板10にフッ酸などのエッチャントでエッチングして凹部11を形成し、この凹部11の底面にスパッタリング、真空蒸着などによりAu、Pt、Cuなどから選ばれた金属の薄膜からなる検出電極12を形成する。一方、第1実施形態の製造方法と同様に行い、第1シリコンウェーハ21を熱酸化してその両面に

酸化膜20を形成する。その後、第2シリコンウェーハ22を第1シリコンウェーハ21に酸化膜20を介して貼り合わせる。第2シリコンウェーハ22が貼り合わされていない側の第1シリコンウェーハ21の表面をその上に形成されている酸化膜20と共に所定の厚さに研削研磨して単結晶シリコン層23を形成する。その結果、単結晶シリコン層23、酸化膜20及び第2シリコンウェーハ22からなる構造体24が形成される。この構造体24を単結晶シリコン層23が凹部11に対向するようにガラス基板10に陽極接合する。その後、第2シリコンウェーハ22を酸化膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する。次いで酸化膜20を除去して単結晶シリコン層23を露出させる。その後、露出した単結晶シリコン層23の表面にスパッタリングによりA1膜25を形成し、パターニングした後、SF<sub>6</sub>ガスによる低温での異方性ドライエッチングを行い、最後にA1膜25を除去する。これにより単結晶シリコン層23が選択的にエッチング除去され、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつ検出電極12の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とが形成された半導体慣性センサ50が得られる。

【0026】図7は第1実施形態の半導体慣性センサ30の別の製造方法を示す。第1実施形態のセンサ30の製法との相違点は、構造体24をガラス基板10に接合した後、第2シリコンウェーハ22を酸化膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程までは第1実施形態の製法と同じであり、それ以後の工程で相違する。即ち、構造体24を構成する第2シリコンウェーハ22のエッチング除去により露出した酸化膜20をフッ酸等のエッチャントを用いてパターニングし、酸化膜20a、20b及び20cを単結晶シリコン層23上に選択的に形成する。この状態で、SF<sub>6</sub>ガスによる低温での異方性ドライエッチングを行い、最後に酸化膜20a、20b及び20cを除去する。これにより単結晶シリコン層23が選択的にエッチング除去され、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつガラス基板10の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とが形成された半導体慣性センサ30が得られる。

【0027】図8は第2実施形態の半導体慣性センサ40の別の製造方法を示す。第2実施形態のセンサ40の製法との相違点は、構造体24をガラス基板10に接合した後、第2シリコンウェーハ22を酸化膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程までは第2実施形態の製法と同じであり、それ以後の工程で相違する。即ち、図7で示す製法と同様に、構造体24を構成する第2シリコンウェーハ22のエッチング除去により露出した酸化膜20をフッ酸等のエッチャントを用いて

パターニングし、酸化膜20a、20b及び20cを単結晶シリコン層23上に選択的に形成する。この状態で、SF<sub>6</sub>ガスによる低温での異方性ドライエッチングを行い、最後に酸化膜20a、20b及び20cを除去する。これにより単結晶シリコン層23が選択的にエッチング除去され、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる枠体29、29と枠体29、29に挟まれかつ検出電極12の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とが形成された半導体慣性センサ40が得られる。

【0028】図9は第3実施形態の半導体慣性センサ50の別の製造方法を示す。第3実施形態のセンサ50の製法との相違点は、構造体24をガラス基板10に接合した後、第2シリコンウェーハ22を酸化膜20をエッチストップ層としてエッチング除去する工程までは第3実施形態の製法と同じであり、それ以後の工程で相違する。即ち、図7で示す製法と同様に、構造体24を構成する第2シリコンウェーハ22のエッチング除去により露出した酸化膜20をフッ酸等のエッチャントを用いてパターニングし、酸化膜20a、20b及び20cを単結晶シリコン層23上に選択的に形成する。この状態で、SF<sub>6</sub>ガスによる低温での異方性ドライエッチングを行い、最後に酸化膜20a、20b及び20cを除去する。これにより単結晶シリコン層23が選択的にエッチング除去され、ガラス基板10上に接合した単結晶シリコンからなる一対の固定電極27、28と一対の固定電極27、28に挟まれかつ検出電極12の上方に浮動する単結晶シリコンからなる可動電極26とが形成された半導体慣性センサ50が得られる。

【0029】

【発明の効果】以上述べたように、従来のウェーハのレーザ加工による半導体慣性センサの製法と異なり、本発明によればレーザ加工が不要となり、大量生産に適した低コストの半導体慣性センサを製作することができる。また可動電極部を形成する前に可動電極部と検出電極部との接合を行うため、第一に従来のような貼り付き(sticking)現象を生じず、検出電極やガラス基板に対して所定のギャップで可動電極を設けることができる。また第二に接合時に検出電極部とのアライメントを行う必要がなく、可動電極形成時に精度良くアライメントを行うことができるので、可動電極と検出電極との位置関係のずれは最小限に抑えられる。更に基板をシリコン基板でなく、ガラス基板にすることにより、静電容量で検出を行うセンサでは、素子の寄生容量が低下し、高感度で高精度の半導体慣性センサが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図2のA-A線要部に相当する本発明の第1実施形態の半導体慣性センサ及びその製造工程を示す断面図。

【図2】本発明の第1実施形態の半導体慣性センサの外

斜視図。

【図3】本発明の第2実施形態の半導体慣性センサの外斜視図。

【図4】図3のB-B線要部に相当する本発明の第2実施形態の半導体慣性センサ及びその製造工程を示す断面図。

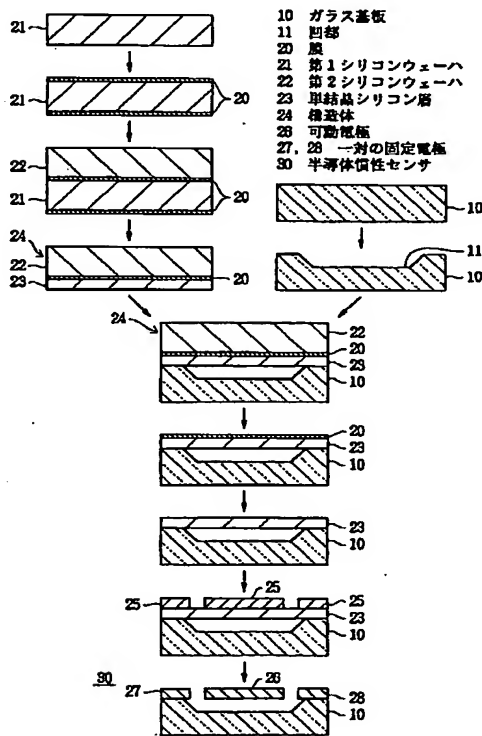
【図5】図6のC-C線要部に相当する本発明の第3実施形態の半導体慣性センサ及びその製造工程を示す断面図。

【図6】本発明の第3実施形態の半導体慣性センサの外斜視図。

【図7】本発明の第1実施形態の半導体慣性センサの別の製造工程を示す断面図。

【図8】本発明の第2実施形態の半導体慣性センサの別

【図1】



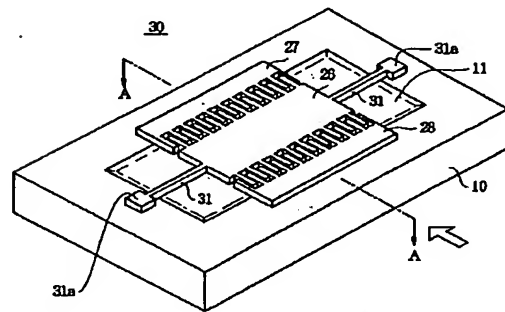
の製造工程を示す断面図。

【図9】本発明の第3実施形態の半導体慣性センサの別の製造工程を示す断面図。

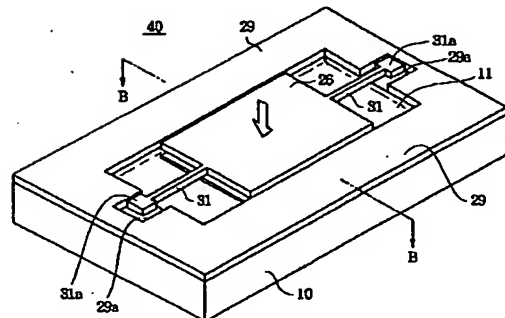
【符号の説明】

- 10 ガラス基板
- 11 凹部
- 12 検出電極
- 21 第1シリコンウェーハ
- 22 第2シリコンウェーハ
- 23 単結晶シリコン層
- 24 構造体
- 26 可動電極
- 27, 28 一對の固定電極
- 30, 40, 50 半導体慣性センサ

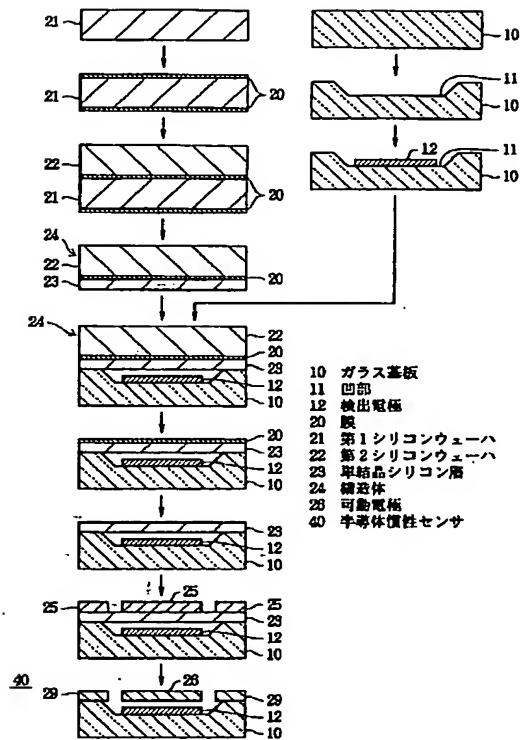
【図2】



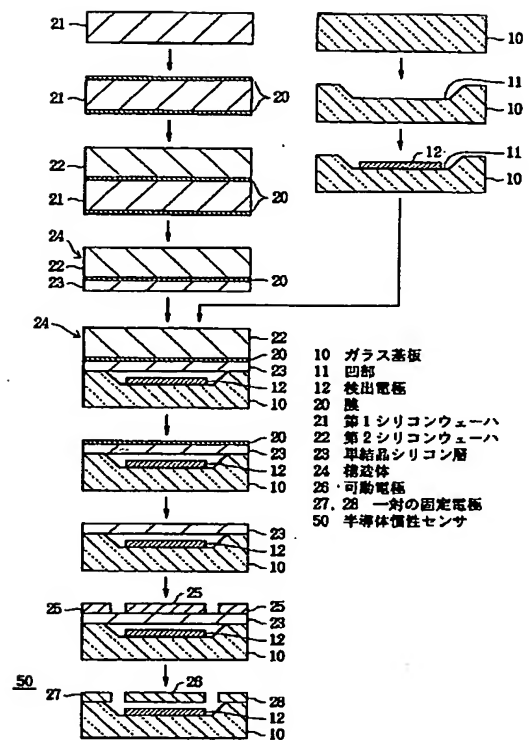
【図3】



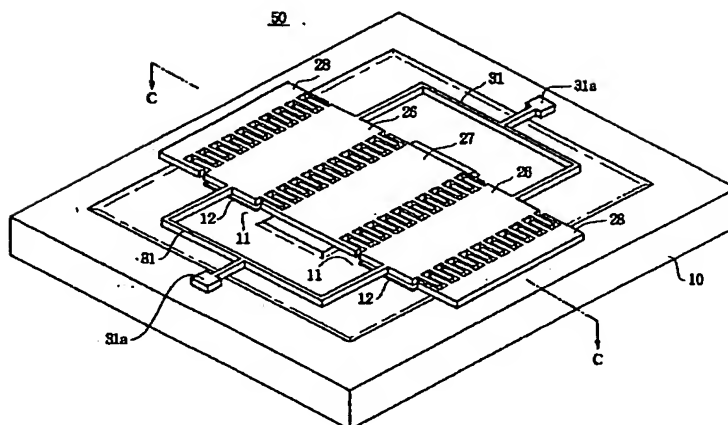
【図4】



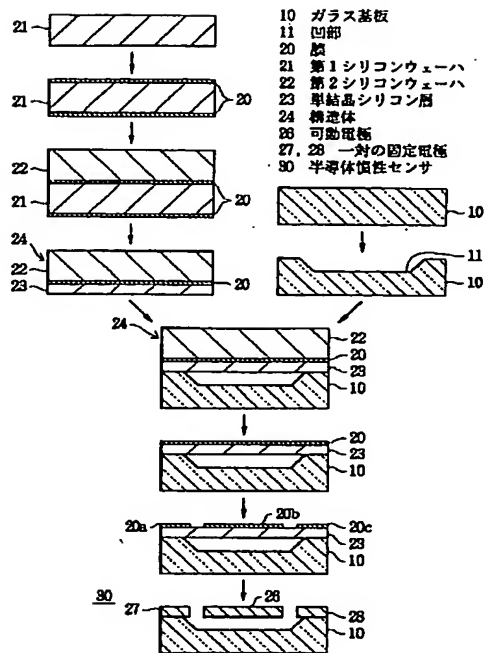
【図5】



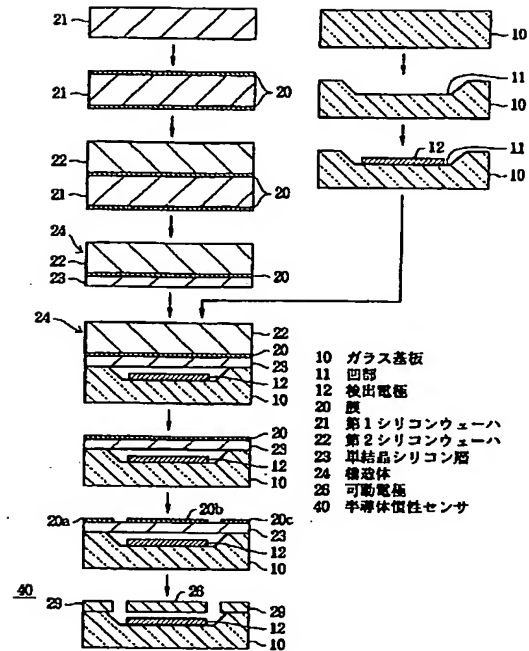
【図6】



【図7】



【図8】



【図9】

